

Сведения о ведущей организации
по диссертации Копьева Виктора Васильевича
«Влияние встроенных электрических полей на перенос носителей заряда
в излучающих структурах InGaN/GaN»
по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ТПУ, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томский политехнический университет
Место нахождения	Российская Федерация, г. Томск
Почтовый индекс, адрес	634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30
Телефон	+7 (3822) 60-63-33
Адрес электронной почты	tpu@tpu.ru
Адрес официального сайта	https://tpu.ru/
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1.	Barchuk M. Defect-rich GaN interlayer facilitating the annihilation of threading dislocations in polar GaN crystals grown on (0001)-oriented sapphire substrates / M. Barchuk, M. Motylenko, T. Schneider, M. Förste, C. Röder, A. Davydok, S. Lazarev, C. Schimpf, C. Wüstefeld, O. Pätzold, D. Rafaja / Journal of Applied Physics. – 2019. – Vol. 126. – P. 085301–1–10. – DOI: 10.1063/1.5092284 (<i>Web of Science</i>).
2.	Gradoboev A. Analysis of the use of reflectors and reflective surfaces for increasing the light efficiency of leds based on AlGaInP heterostructures. / A. Gradoboev, K. Orlova, A. Simonova / B: Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 942. – P. 77–86. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.942.77 (<i>Scopus</i>).
3.	Lazarev S. Structural Changes in a Single GaN Nanowire under Applied Voltage Bias / S. Lazarev, D. Dzhigaev, Z. Bi, A. Nowzari, Y. Y. Kim, M. Rose, I. A. Zaluzhnyy, O. Y. Gorobtsov, A. V. Zozulya, F. Lenrick, A. Gustafsson, A. Mikkelsen, M. Sprung, L. Samuelson, I. A. Vartanyants / Nano Letters. – 2018. – Vol. 18. – P. 5446–5452. – DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01802 (<i>Scopus</i>).
4.	Gradoboev A. V. Combined Action of Fast Neutrons and Operational Factors on Reliability of Infrared LEDs / A. V. Gradoboev, A. V. Simonova, K. N. Orlova / Inorganic Materials: Applied Research. – 2018. – Vol. 9, № 5. – P. 848–854. – DOI: 10.1134/S207511331805012X (<i>Scopus</i>).
5.	Gradoboev A. V. LEDs based upon AlGaInP heterostructures with multiple quantum wells: Comparison of fast neutrons and gamma-quanta irradiation / A. V. Gradoboev, K. N. Orlova, A. V. Simonova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 363, № 1. : 2nd International Conference on Cognitive Robotics, Tomsk, Russian Federation; November 22–November 25, 2017. – Article number 012010. – 4 p. – DOI: 10.1088/1757-899X/363/1/012010 (<i>Scopus</i>).

	D. Dzhigaev, T. Stankevič, Z. Bi, S. Lazarev, M. Rose, A. Shabalin, J. Reinhardt, A. Mikkelsen, L. Samuelson, G. Falkenberg, R. Feidenhans'l, I. A. Vartanyants / ACS Nano. – 2017. – Vol. 11. – P. 6605–6611. – DOI: 10.1021/acsnano.6b08122 (<i>Scopus</i>).
7.	Gradoboev A. V. Influence of irradiation by ^{60}Co gamma-quanta on reliability of IR-LEDs based upon AlGaAs heterostructures / A. V. Gradoboev, A. V. Simonova, K. N. Orlova / Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics. – 2016. – Vol. 13, № 10–12. – P. 895–902. – DOI: 10.1002/pssc.201600035 (<i>Scopus</i>).
8.	Gradoboev A. V. The fast neutron irradiation influence on the AlGaAs IR-LEDs reliability / A. V. Gradoboev, K. N. Orlova, I. A. Asanov, A. V. Simonova / Microelectronics Reliability. – 2016. – Vol. 65. – P. 55–59. – DOI: 10.1016/j.microrel.2016.07.143 (<i>Web of Science</i>).
9.	Lisitsyn V. M. White LEDs with limit luminous efficacy / V. M. Lisitsyn, V. S. Lukash, S. A. Stepanov, Ju Yangyang / AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1698. – P. 060008–1–5. – DOI: 10.1063/1.4937863 (<i>Web of Science</i>).
10.	Олешко В. И. Морфология разрушений в гетероструктурах InGaN/GaN под действием сильнофокусированного электронного пучка / В. И. Олешко, С. Г. Горина / Письма в ЖТФ. – 2015. – Т. 41, № 15. – С. 75–82. <i>в переводной версии журнала:</i> Oleshko V. I. The Morphology of High Current Electron Beam Initiated Fractures in InGaN/GaN Heterostructures / V. I. Oleshko, S. G. Gorina / Technical Physics Letters. – 2015. – Vol. 41, № 8. – P. 750–752. – DOI: 10.1134/S1063785015080143 (<i>Web of Science</i>).
Прочие публикации работников ведущей организации по теме диссертации за последние 5 лет	
11.	Кистенева М. Г. Оптические и волноводные свойства эпитаксиальных структур GaN/InGaN, выращенных на сапфировой подложке / М. Г. Кистенева, А. С. Акрестина, Е. С. Худякова, В. В. Щербина, М. В. Бородин, В. М. Шандаров, С. М. Шандаров, В. М. Лисицын, С. А. Степанов / Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т. 58, № 8/3. – С. 276–278.

Верно

Проректор по научной работе и инновациям

10.10.2019



И. Б. Степанов

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
«National Research Tomsk Polytechnic University» (TPU)
30, Lenin ave., Tomsk, 634050, Russia
Tel. +7-3822-606333, +7-3822-701779,
Fax +7-3822-606444, e-mail: tpu@tpu.ru, tpu.ru
OKPO (National Classification of Enterprises and Organizations):
02069303,
Company Number: 027000890168,
VAT/KPP (Code of Reason for Registration)
7018007264/701701001, BIC 046902001

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» (ТПУ)
Ленина, пр., д. 30, г. Томск, 634050, Россия
тел.: +7-3822-606333, +7-3822-701779,
факс +7-3822-606444, e-mail: tpu@tpu.ru, tpu.ru
ОКПО 02069303, ОГРН 1027000890168,
ИНН/КПП 7018007264/701701001, БИК 046902001

10.10.2019 № 03/7792
на № _____ от _____

Председателю диссертационного совета
Д 212.267.07, созданного на базе федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский
Томский государственный университет»,
доктору физико-математических наук,
профессору

В. Г. Багрову

Уважаемый Владислав Гаврилович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» ведущей организацией по диссертации Копьева Виктора Васильевича «Влияние встроенных электрических полей на перенос носителей заряда в излучающих структурах InGaN/GaN» по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в автореферат диссертации В. В. Копьева и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Проректор по научной работе и инновациям



И. Б. Степанов